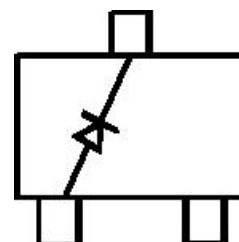




安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

MMBD4148



SOT-23 内部结构

SWITCHING DIODE 開關二極管

■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^{\circ}\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	I_F	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V_R	75	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T_J, T_{stg}	-55to+150 $^{\circ}\text{C}$	

■DEVICE MARKING 打標

MMBD4148=A6

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

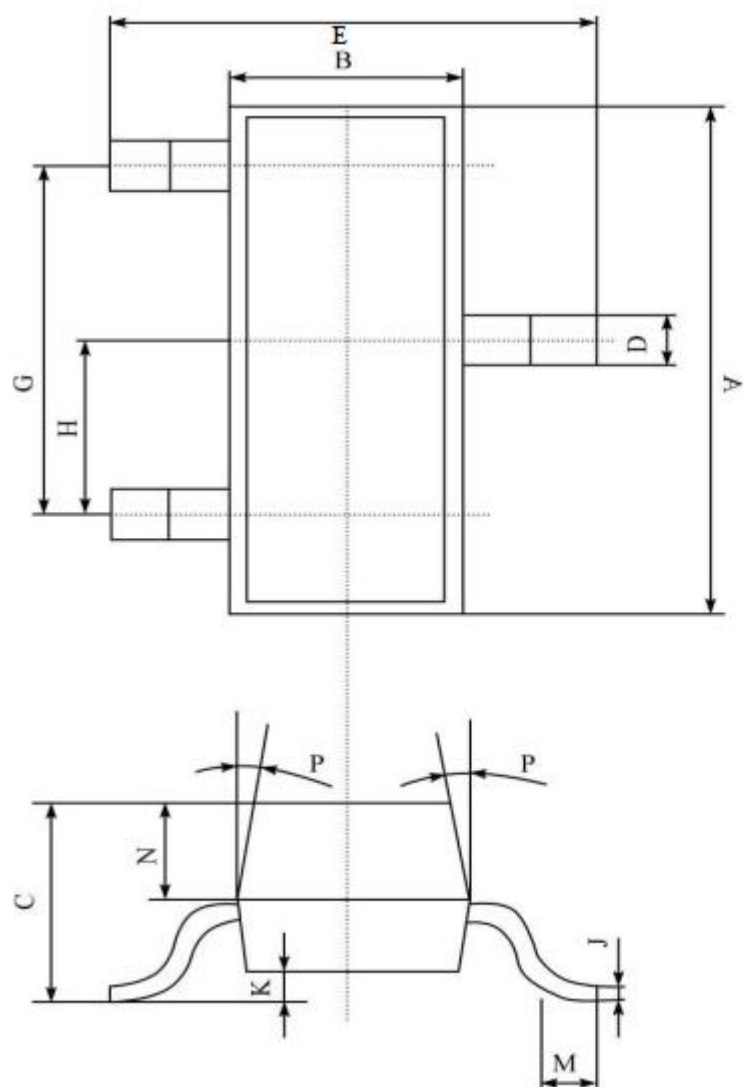
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊说明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=100\mu\text{A}$)	$V_{(BR)}$	75	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=75\text{V}$)	I_R	—	1	μA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=1\text{mA}$ $I_F=10\text{mA}$ $I_F=50\text{mA}$ $I_F=150\text{mA}$	V_F	 —	715 855 1000 1250	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_D	—	2	pF

MMBD4148

■ DIMENSION 外形封装尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°